

摘要

TPS65219 系列电源管理集成电路 (PMIC) 包含一个可配置的非易失性存储器 (NVM) 空间。本编程人员指南详细介绍了定义 PMIC 默认配置的分步编程说明以及如何对 NVM 重新编程。

内容

1 引言	3
2 NVM 编程的硬件要求	4
3 典型 NVM 流程	5
4 编程指令	8
4.1 配置使能设置	8
4.2 配置降压转换器	10
4.3 配置 LDO	11
4.4 配置 GPIO	13
4.5 配置序列	14
4.6 配置多功能引脚	17
4.7 配置 EN/PB/VSENSE 引脚	20
4.8 更改 I2C 地址	20
4.9 配置屏蔽设置	21
4.10 NVM 重新编程	22
A 非 NVM 寄存器	24
B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC	25
C PMIC 可配置字段	26
D 参考文献	28

插图清单

图 1-1. 供应选项	3
图 2-1. NVM 编程的硬件设置	4
图 3-1. 插槽式 EVM	5
图 3-2. 原型示例	6
图 3-3. TPS65219-GUI	7
图 4-1. NVM 编程	8
图 4-2. 使用 TPS65219-GUI 的使能设置	9
图 4-3. 使用 TPS65219-GUI 的降压转换器设置	10
图 4-4. 使用 TPS65219-GUI 的 LDO 设置	12
图 4-5. GPIO 配置	14
图 4-6. 序列配置	15
图 4-7. 使用 TPS65219-GUI 的多功能配置	18
图 4-8. 使用 TPS65219-GUI 的 EN/PB/VSENSE 配置	20
图 4-9. I2C_ADDRESS_REG	21
图 4-10. TPS65219-GUI 中的屏蔽设置	21
图 4-11. 使用 TPS65219-GUI 重新对 NVM 进行编程	22
图 4-12. 使用 TPS65219-GUI 导出 NVM 设置	23
图 B-1. 加载 NVM 配置文件	25
图 C-1. NVM 可编程字段	27

表格清单

表 1-1. TPS65219 用户可编程型号.....	3
表 2-1. NVM 编程的最低硬件要求.....	4
表 4-1. 用于使能设置的 NVM 寄存器.....	9
表 4-2. 用于 Buck1 配置的 NVM 寄存器.....	11
表 4-3. 用于 Buck2 配置的 NVM 寄存器.....	11
表 4-4. 用于 Buck3 配置的 NVM 寄存器.....	11
表 4-5. 用于开关模式的 NVM 寄存器 (仅在 BUCK_FF_ENABLE = 1h 时适用)	11
表 4-6. 用于 LDO1 设置的 NVM 寄存器.....	12
表 4-7. 用于 LDO2 设置的 NVM 寄存器.....	12
表 4-8. 用于 LDO3 设置的 NVM 寄存器.....	13
表 4-9. 用于 LDO4 设置的 NVM 寄存器.....	13
表 4-10. 用于 GPIO 设置的 NVM 寄存器.....	14
表 4-11. 用于多 PMIC 配置的 NVM 寄存器.....	14
表 4-12. 上电序列 - 时隙分配.....	15
表 4-13. 上电序列 - 时隙持续时间.....	16
表 4-14. 下电序列 - 时隙分配.....	16
表 4-15. 下电序列 - 时隙持续时间.....	17
表 4-16. 用于 VSEL_SD/VSEL_DDR 的 NVM 寄存器.....	18
表 4-17. 用于 MODE/STBY 的 NVM 寄存器.....	18
表 4-18. 用于 MODE/RESET 的 NVM 寄存器.....	19
表 4-19. 用于 EN/PB/SENSE 的 NVM 寄存器.....	20
表 4-20. I2C_ADDRESS_REG.....	21
表 4-21. 寄存器 0x1E 上的屏蔽设置.....	21
表 4-22. 寄存器 0x1E 上的屏蔽设置.....	22
表 4-23. 寄存器 0x1E 上的屏蔽设置.....	22
表 4-24. 用以将寄存器设置保存到 NVM 中的 I2C 写入.....	23

商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

1 引言

本文档中描述的配置过程写入 NVM 空间，旨在用于生产线或原型板。该机制不适用于最终应用，因为该过程会影响稳压器输出和数字引脚功能。TPS6521905 属于 TPS65219 系列，是专为支持定制 NVM 配置而创建的可订购器件型号。表 1-1 显示了用户可编程型号以及支持的封装尺寸、温度和开关模式。图 1-1 介绍了针对预配置 NVM 和基于容量的定制 NVM 的供应选项。设计资源不仅可用于预配置的 NVM 和大容量 NVM，还可用于小容量定制 NVM。这些资源包括应用手册、用户指南、技术参考手册以及可立即加载到 PMIC NVM 中的 NVM 配置文件。访问 TI.com 上的 TPS6521905 产品页面或使用我们的 [PMIC E2E 论坛](#)，查看可用资源。

备注

为了支持 NVM 编程，TI 提供了两种插槽式 EVM，每种 EVM 采用不同的封装尺寸。**TPS65219EVM-SKT** 是 5x5 插槽式 EVM 的可订购器件型号，**TPS65219EVM-RSM** 是 4x4 插槽式 EVM 的可订购器件型号。

表 1-1. TPS65219 用户可编程型号

OPN	封装	温度	支持的开关频率
TPS6521905RHBR	RHB - 5x5 (0.5mm 间距)	Ta = -40°C 至 105°C Tj = -40°C 至 125°C	准固定频率 (自动 PFM 和强制 PWM)
TPS6521905RSMR	RSM - 4x4 (0.4mm 间距)	Ta = -40°C 至 105°C Tj = -40°C 至 125°C	准固定频率 (自动 PFM 和强制 PWM)
TPS6521905WRHBRQ1	RHB - 5x5 (0.5mm 间距) 可湿性侧面	Ta = -40°C 至 125°C Tj = -40°C 至 150°C	准固定频率 (自动 PFM 和强制 PWM)
可应要求提供	RHB - 5x5 (0.5mm 间距) 可湿性侧面	Ta = -40°C 至 125°C Tj = -40°C 至 150°C	固定频率 (推荐用于需要最佳 EMI 控制的应用。可提供展频和异相关关)

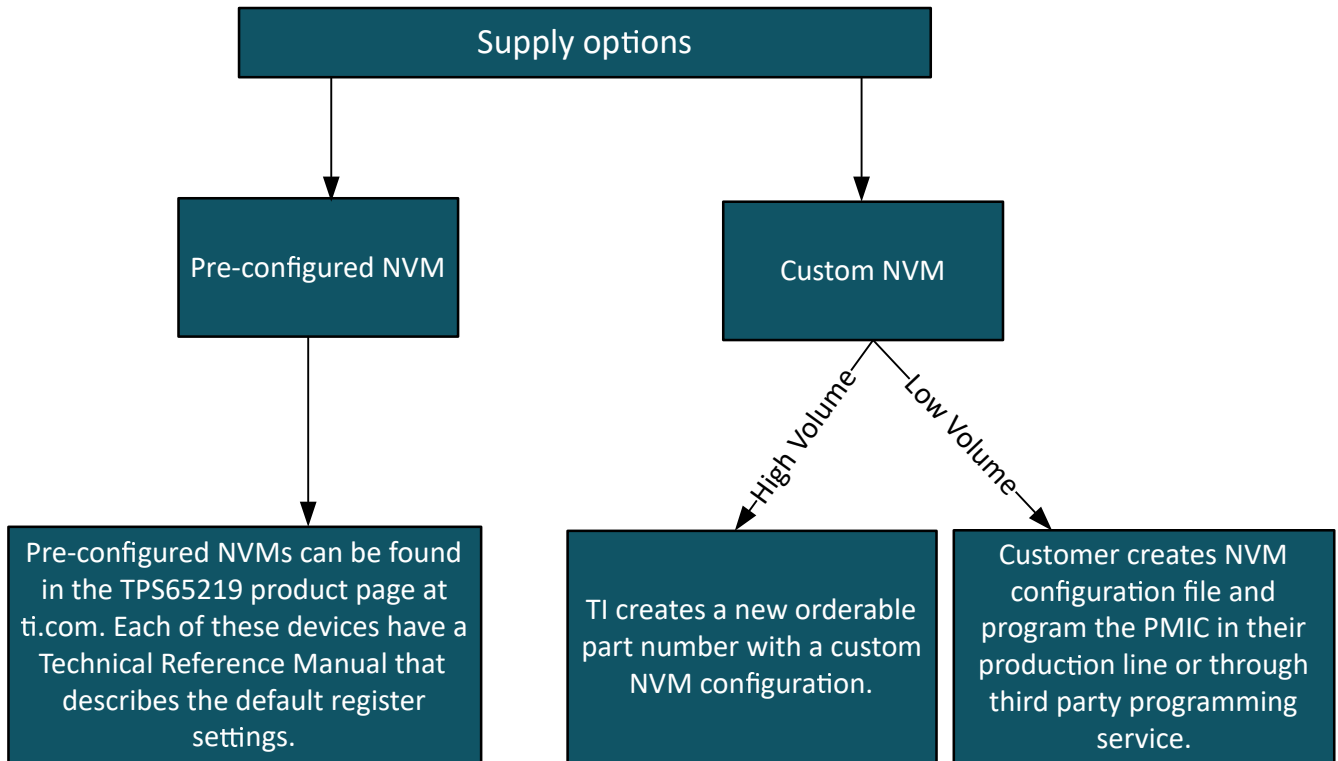


图 1-1. 供应选项

2 NVM 编程的硬件要求

PMIC 有两个存储器空间：寄存器映射空间和 NVM 空间。对 NVM 重新编程的方法是：首先通过串行接口 (I2C) 写入寄存器映射，然后将寄存器设置保存到 NVM 中。由于配置首先需要写入控制稳压器和数字引脚的寄存器映射，因此必须对 PMIC 资源没有依赖或使用需求。例如，在重新对 NVM 进行编程时，必须使用外部电源为 I2C 引脚的上拉电阻供电，而不是使用其中一个 PMIC 电源器件。表 2-1 和图 2-1 显示了在 PMIC 和编程器件之间进行硬件设置的最低硬件要求。

备注

在初始化状态下重新对 NVM 进行编程时，不需要其他外部元件，如电感器、电容器等。但是，在活动状态下运行 PMIC 并验证 NVM 设置需要这些元件。

表 2-1. NVM 编程的最低硬件要求

器件引脚	所需的连接
VSYS	VSYS 电压必须为 3.3V 或更高，并且不得超过规格中建议的最大电压。 VSYS 必须具有至少 2.2uF 的电容器。
VDD1P8	VDD1P8 必须具有 2.2uF 的电容器
I2C 引脚	I2C 引脚上的上拉电阻 (SDA/SCL) 必须由外部 3.3V 电源供电。 PMIC 的 I2C 引脚必须由外部 I2C 器件驱动，该器件可以与 PMIC 通信并写入寄存器。
EN/PB/VSENSE	EN/PB/VSENSE 引脚必须通过上拉电阻连接到 VSYS。
AGND	AGND (引脚编号 15) 必须通过过孔连接到 PCB 接地层。保持 AGND 引脚与过孔之间的布线较短。
散热焊盘	封装散热焊盘必须通过至少九个过孔连接到 PCB 接地层。

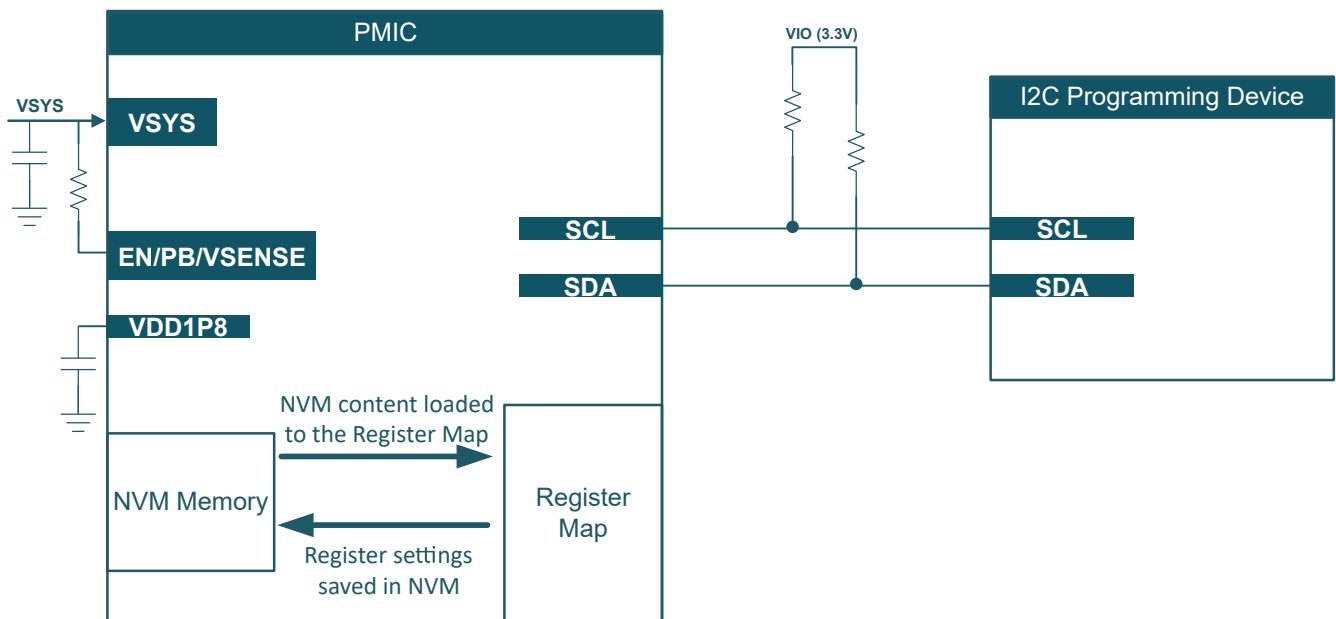


图 2-1. NVM 编程的硬件设置

3 典型 NVM 流程

本节介绍了典型的 NVM 定义流程，其中包括以下步骤：系统要求、硬件设置、NVM 编程和测试/验证。

1. 系统要求

确定系统要求并构建配电网 (PDN)。电压/电流、上电/下电序列、低功耗模式和负载瞬态是处理器、SoC 和外设的典型要求。

2. 硬件设置

TPS65219 可使用 PMIC 插槽式 EVM、客户原型板 (电路内编程) 或生产线进行编程。

- **插槽式 EVM**：PMIC 插槽式 EVM 附带板载 MSP340，后者可通过 I2C 与 PMIC 通信，以对 NVM 存储器进行重新编程。此硬件还集成了一个分立式 3.3V LDO，当 PMIC 电源轨在初始化状态下关闭时，该 LDO 可以为 I2C 上拉电阻供电。

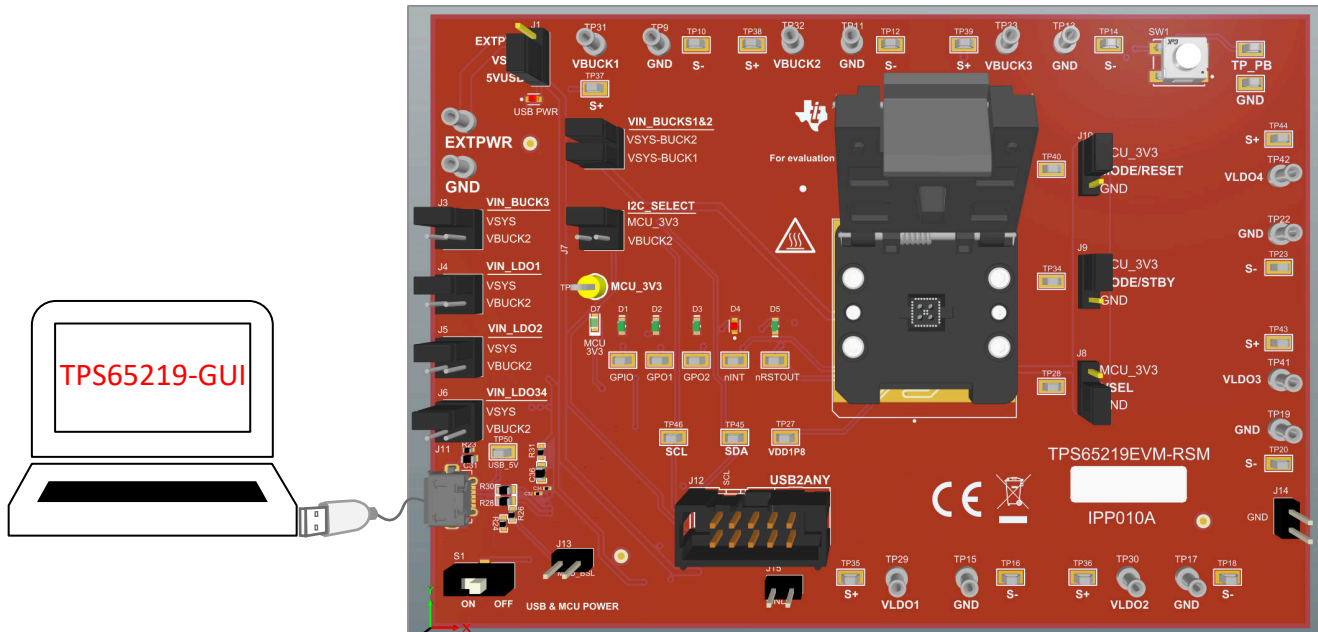


图 3-1. 插槽式 EVM

- **原型板**：默认情况下，用户可编程的 TPS6521905 NVM 附带的所有电源资源均处于非活动状态，并且 EN/PB/VSENSE 引脚配置为“Push-Button”，FSD 处于禁用状态 (PU_ON_FSD = 0x0)。如果此引脚上拉至 VSYS，当有效电源连接到 VSYS 时，PMIC 会保持关闭状态 (初始化状态)。此配置允许在执行上电序列之前重新对 NVM 进行编程。图 3-2 展示了客户需要在原型板中包含哪些内容来重新对 PMIC NVM 进行编程。所需的元件包括 GND、SCL、SDA 上的三个测试点，以及一个 1x3 单排接头连接器，该连接器会在外部 3.3V 和 PMIC 电源轨 (在正常应用中为 I2C 引脚供电) 之间选择上拉电源。USB2ANY (可在 TI.com 上获取) 可用于与 PMIC 通信并对 NVM 设置重新编程。

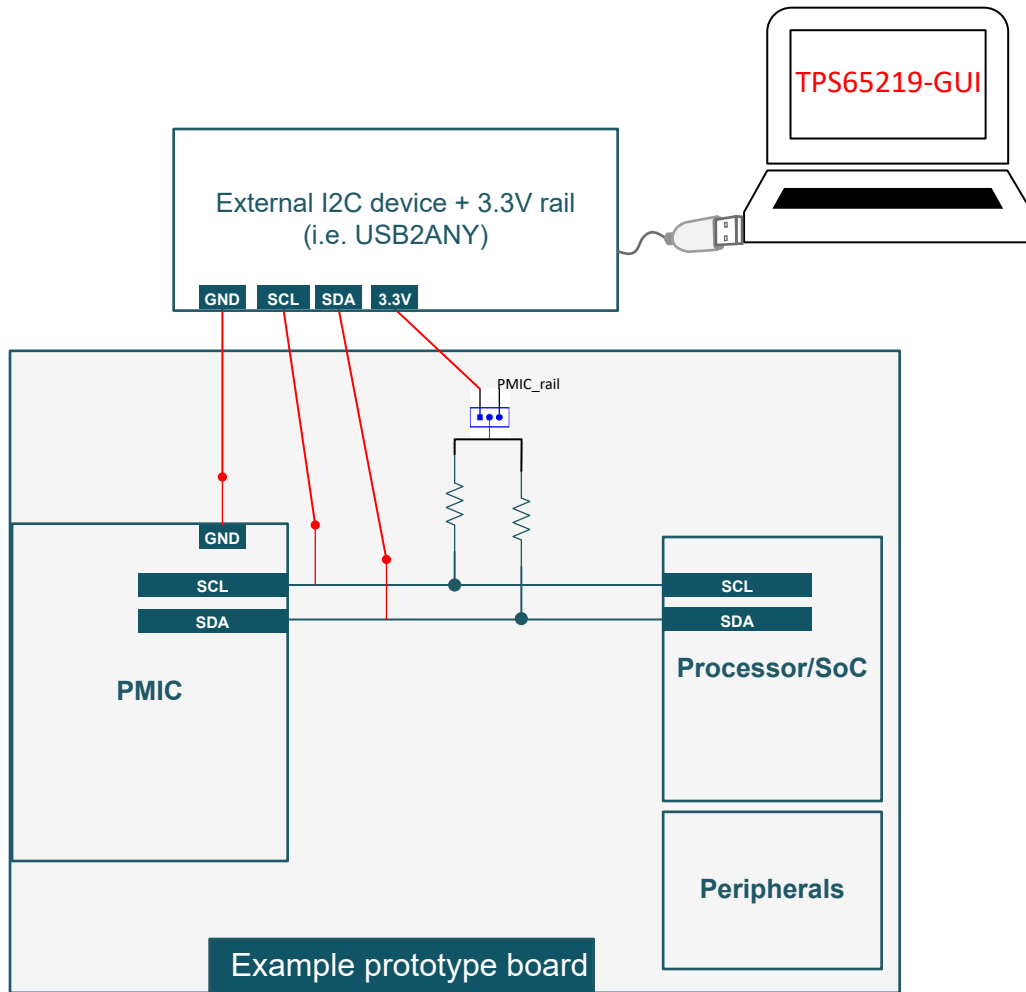


图 3-2. 原型示例

备注

有关推荐的外部元件（如电感器、输出电容等），请参阅数据表中的“规格”和“详细设计过程”部分。

- **生产线**：在将器件焊接到最终 PCB 之前，还可以根据图 2-1 在生产线中重新对 PMIC NVM 进行编程。

3. NVM 编程

按照节 4 中的编程说明更改寄存器设置，并将新值保存到 NVM 存储器中。TPS65219-GUI 可与插座式 EVM（或原型板加外部 USB2ANY）配合使用。或者，客户可以使用他们首选的 I2C 调试器工具，在不使用 TPS65219-GUI 的情况下写入每个 NVM 寄存器。重新对 NVM 进行编程后，建议执行下电上电以确认新的寄存器设置是否已保存到 NVM 存储器中。

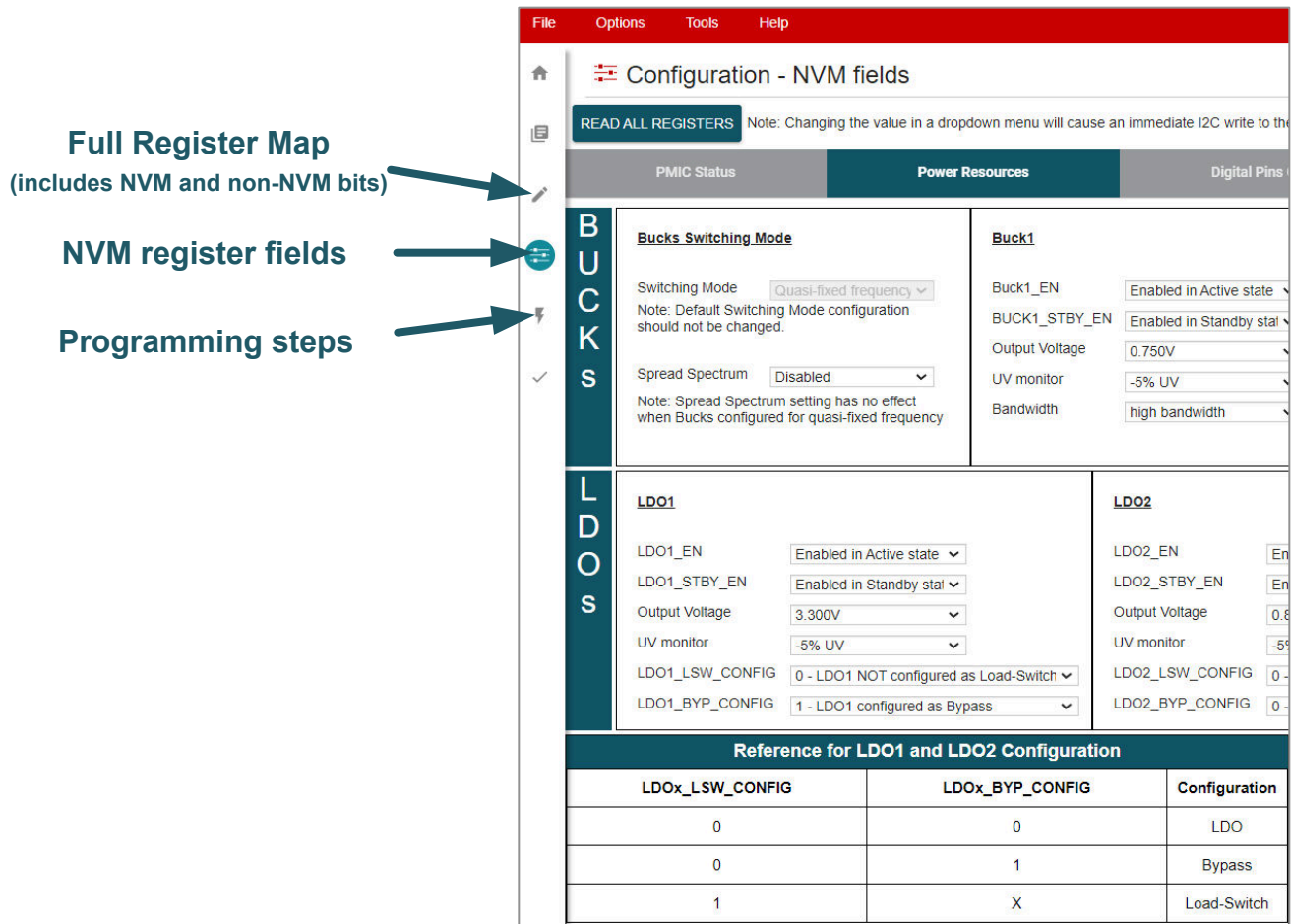


图 3-3. TPS65219-GUI

4. NVM 测试

必须测试 NVM 设置以确认预期的 PMIC 行为。下面的列表显示了建议的最低测试。这些测试可以在插座式 EVM 或原型板上执行。如果使用插座式 EVM 对 PMIC 重新编程，则可以将器件焊接到客户原型板中，以测试和验证系统级功能。或者，可以替换焊接在 TPS65219EVM 上的 PMIC，以测试定制 NVM 配置。

- 测量所有输出电压
- 为上电序列收集示波器波形 (包括 GPIO [若已启用]和 nRSTOUT)
- 为下电序列收集示波器波形 (包括 GPIO [若已启用]和 nRSTOUT)
- 测试 EN/PB/VSENSE 引脚功能和极性以触发 ON 和 OFF 请求。
- 测试每个多功能引脚 (VSEL、MODE/STBY、MODE/RESET) 的配置和极性。将此引脚拉至高电平或低电平，并根据配置的引脚功能验证 PMIC 行为是否发生变化。

备注

该插槽式 EVM 可用于重新编程和基本测试 (例如：测量输出电压以及收集上电序列波形等)，但不得用于测试负载瞬态和效率等特定性能参数，因为插座弹簧针和布局放置会引入不代表应用设计的更高寄生效应。

4 编程指令

本节介绍了对 PMIC NVM 进行编程所需的步骤。编程过程主要包括两个步骤：更改寄存器设置和将新值保存到 NVM 存储器中。TI 建议在初始化状态下对 NVM 进行编程，在这种状态下，为 VSYS 供电，但所有 PMIC 输出和监视器都关闭。

图 4-1 展示了对器件重新编程的步骤。第一条命令包含将器件发送到初始化状态的 I2C OFF 请求。仅当器件未处于初始化状态时才需要此命令。第二个 I2C 命令用于启用内部振荡器进行 I2C 通信，并禁用电源轨放电。第三步需要按照编程说明更新寄存器设置，以匹配特定的应用要求。更新寄存器设置后，可以通过将 0x0A 写入寄存器地址 0x34 而将新值保存到 NVM 中。最后一步“验证”是可选的，包含一条将寄存器设置与 NVM 内容进行比较的 I2C 命令。

备注

仅当 PMIC 未处于初始化状态时，才需要第一个 I2C 命令 (I2C OFF 请求)。默认情况下，用户可编程的 OPN TPS6521905 的 EN/PB/VSENSE 引脚配置为“Push-Button”，且 FSD 功能处于禁用状态。当配置为 PB 时，该器件会在引脚被拉低时检测到 ON 请求。如果该引脚上拉至 VSYS，则在为 VSYS 供电后，PMIC 保持初始化状态。为了验证在初始化状态下是否支持 I2C 通信，建议读取地址 0x01 上的 NVM ID 寄存器。回读操作与器件型号中“TPS65219”后面的两位数字匹配。例如，当使用 TPS6521905 时，寄存器 0x01 读取 05。

1 Send I2C OFF Request	Register Address: 0x29 Data: 0x01 (I2C_OFF_REQ)
2 Enable I2C Communication	Register Address: 0x34 Data: 0x09 (EN_OSC_DIY)
3 Update register settings	This step requires updating the correct register settings to match specific application requirements
4 NVM Programming	Register Address: 0x34 Data: 0x0A (EN_OSC_DIY)
5 NVM Validation	Register Address: 0x34 Data: 0x07 (EN_OSC_DIY)

图 4-1. NVM 编程

4.1 配置使能设置

PMIC 具有活动和待机状态，可以在这两个状态下启用或禁用电源轨。当配置为 STBY 时，可以通过 MODE/STBY 引脚触发状态变化。

- 图 4-2 显示了使用 TPS65219-GUI 时需要更改的设置。

- 表 4-1 显示了不使用 TPS65219-GUI 时要写入的寄存器字段。

Reference for LDO1 and LDO2 Configuration		
LDOx_LSW_CONFIG	LDOx_BYP_CONFIG	Configuration
0	0	LDO
0	1	Bypass
1	X	Load-Switch

图 4-2. 使用 TPS65219-GUI 的使能设置

表 4-1. 用于使能设置的 NVM 寄存器

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
在活动状态下启用电源轨	0x02	6	LDO4_EN	0h = 禁用 1h = 启用
		5	LDO3_EN	0h = 禁用 1h = 启用
		4	LDO2_EN	0h = 禁用 1h = 启用
		3	LDO1_EN	0h = 禁用 1h = 启用
		2	BUCK3_EN	0h = 禁用 1h = 启用
		1	BUCK2_EN	0h = 禁用 1h = 启用
		0	BUCK1_EN	0h = 禁用 1h = 启用

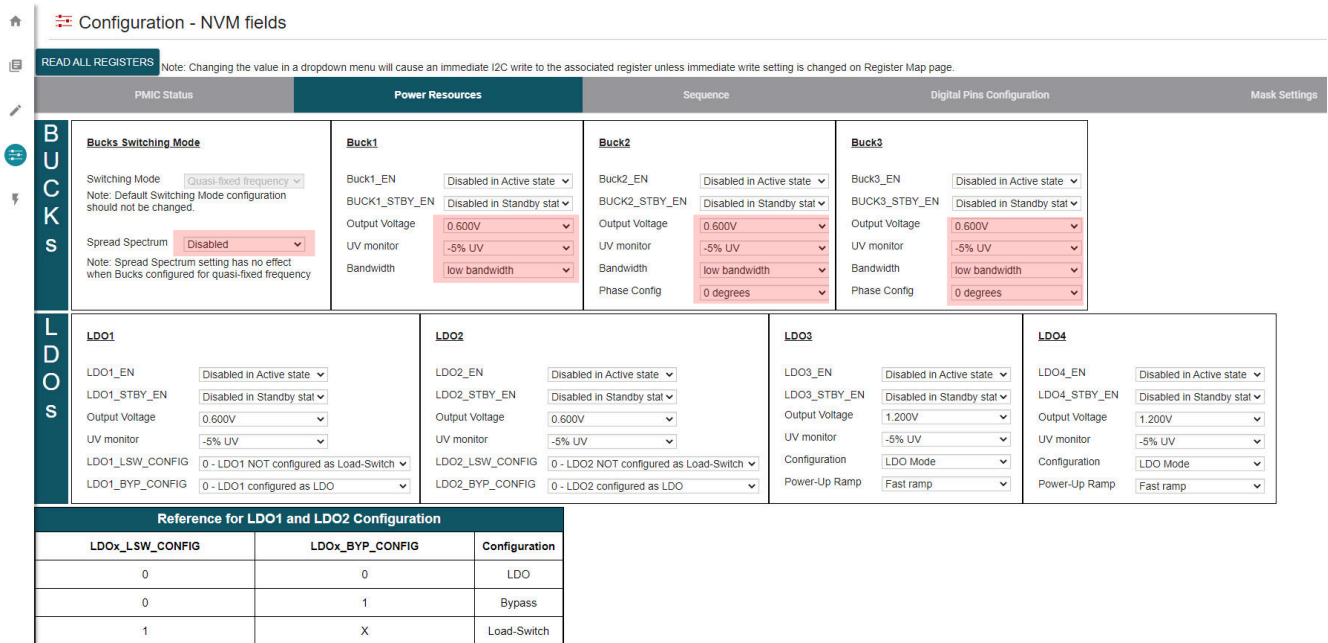
表 4-1. 用于使能设置的 NVM 寄存器 (continued)

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
在待机状态下启用电源轨	0x21	6	LDO4_STBY_EN	0h = 禁用 1h = 启用
		5	LDO3_STBY_EN	0h = 禁用 1h = 启用
		4	LDO2_STBY_EN	0h = 禁用 1h = 启用
		3	LDO1_STBY_EN	0h = 禁用 1h = 启用
		2	BUCK3_STBY_EN	0h = 禁用 1h = 启用
		1	BUCK2_STBY_EN	0h = 禁用 1h = 启用
		0	BUCK1_STBY_EN	0h = 禁用 1h = 启用

4.2 配置降压转换器

可以为降压转换器设定多项设置，其中包括输出电压、欠压 (UV) 监控和带宽等。

- 图 4-3 显示了使用 TPS65219-GUI 时需要更改的设置。
- 表 4-2、表 4-3、表 4-4 和表 4-5 显示了不使用 TPS65219-GUI 时要写入的寄存器字段。



The screenshot shows the 'Configuration - NVM fields' page in the TPS65219 GUI. It is divided into 'BUCKS' and 'LDOs' sections. The 'BUCKS' section includes Buck1, Buck2, and Buck3 configurations, with settings for Buck1_EN, Buck2_EN, Buck3_EN, Buck1_STBY_EN, Buck2_STBY_EN, Buck3_STBY_EN, Output Voltage (0.600V), UV monitor (-5% UV), Bandwidth (low bandwidth), and Phase Config (0 degrees). The 'LDOs' section includes LDO1, LDO2, LDO3, and LDO4 configurations, with settings for LDOx_EN, LDOx_STBY_EN, Output Voltage (0.600V, 1.200V), UV monitor (-5% UV), LDO1_LSW_CONFIG, LDO2_LSW_CONFIG, LDO1_BYP_CONFIG, LDO2_BYP_CONFIG, Configuration (LDO Mode), and Power-Up Ramp (Fast ramp). A 'Reference for LDO1 and LDO2 Configuration' table is also present.

Reference for LDO1 and LDO2 Configuration		
LDOx_LSW_CONFIG	LDOx_BYP_CONFIG	Configuration
0	0	LDO
0	1	Bypass
1	X	Load-Switch

图 4-3. 使用 TPS65219-GUI 的降压转换器设置

表 4-2. 用于 Buck1 配置的 NVM 寄存器

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
带宽	0x0A	7	BUCK1_BW_SEL	0h = 低带宽 1h = 高带宽
UV 监控		6	BUCK1_UV_THR_SEL	0h = -5% UV 检测电平 1h = -10% UV 检测电平
输出电压		5-0	BUCK1_VSET	请参阅数据表上的寄存器映射

表 4-3. 用于 Buck2 配置的 NVM 寄存器

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
带宽	0x09	7	BUCK2_BW_SEL	0h = 低带宽 1h = 高带宽
UV 监控		6	BUCK2_UV_THR_SEL	0h = -5% UV 检测电平 1h = -10% UV 检测电平
输出电压		5-0	BUCK2_VSET	请参阅数据表上的寄存器映射

表 4-4. 用于 Buck3 配置的 NVM 寄存器

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
带宽	0x08	7	BUCK3_BW_SEL	0h = 低带宽 1h = 高带宽
UV 监控		6	BUCK3_UV_THR_SEL	0h = -5% UV 检测电平 1h = -10% UV 检测电平
输出电压		5-0	BUCK3_VSET	请参阅数据表上的寄存器映射

表 4-5. 用于开关模式的 NVM 寄存器 (仅在 BUCK_FF_ENABLE = 1h 时适用)

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
展频	0x03	5	BUCK_SS_ENABLE	0h = 已禁用展频 1h = 已启用展频
开关模式		4	BUCK_FF_ENABLE	请勿更改此位
Buck2/Buck3 相位配置		3-2	BUCK3_PHASE_CONFIG	0h = 0 度 1h = 90 度 2h = 180 度 3h = 270 度
		1-0	BUCK2_PHASE_CONFIG	0h = 0 度 1h = 90 度 2h = 180 度 3h = 270 度

4.3 配置 LDO

可以为 LDO 稳压器设定多项设置，其中包括输出电压、欠压 (UV) 监控等。

- 图 4-4 显示了使用 TPS65219-GUI 时需要更改的设置。
- 表 4-6、表 4-7、表 4-8 和表 4-9 显示了不使用 TPS65219-GUI 时要写入的寄存器字段。

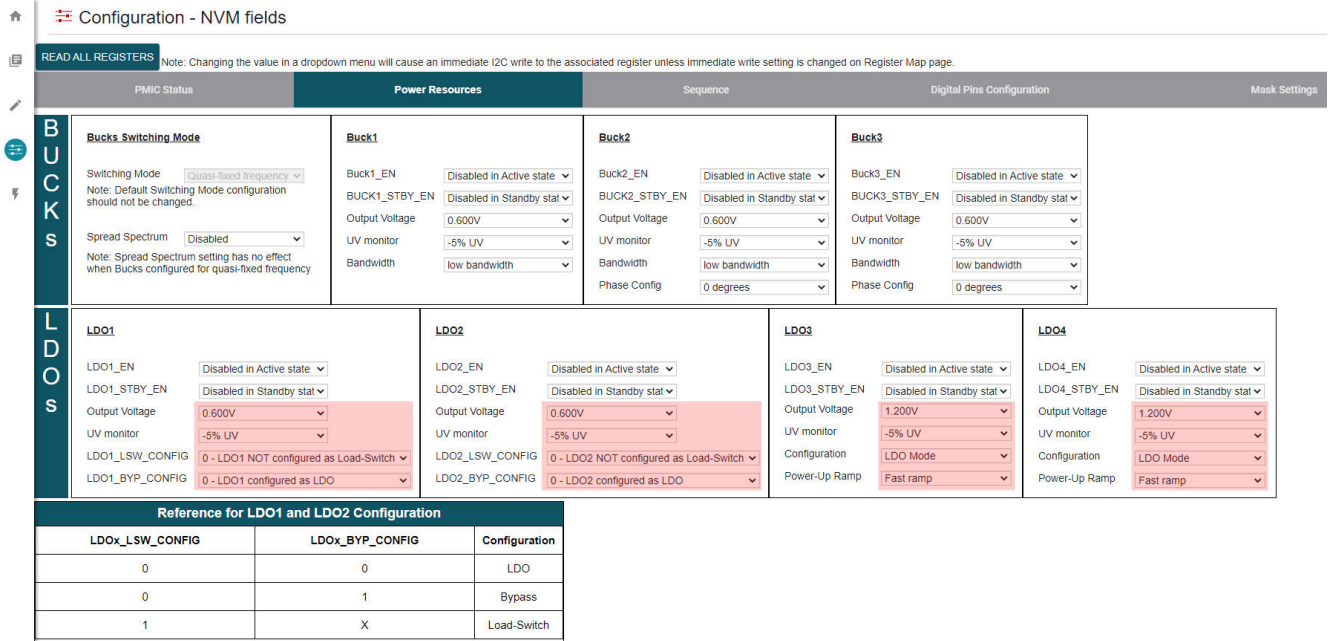


图 4-4. 使用 TPS65219-GUI 的 LDO 设置

表 4-6. 用于 LDO1 设置的 NVM 寄存器

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
输出电压	0x07	5-0	LDO1_VSET	请参阅数据表上的寄存器映射
配置	0x07	7	LDO1_LSW_CONFIG	0h = LDO1 未配置为负载开关 1h = LDO1 配置为负载开关
		6	LDO1_BYP_CONFIG	0h = LDO1 配置为 LDO 1h = LDO1 配置为旁路 (仅适用于 LDO1_LSW_CONFIG 0x0)
UV 监控	0x1E	3	LDO1_UV_THR	0h = -5% UV 1h = -10% UV

表 4-7. 用于 LDO2 设置的 NVM 寄存器

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
输出电压	0x06	7	LDO2_VSET	请参阅数据表上的寄存器映射
配置	0x06	6	LDO2_LSW_CONFIG	0h = LDO1 未配置为负载开关 1h = LDO1 配置为负载开关
		5-0	LDO2_BYP_CONFIG	0h = LDO1 配置为 LDO 1h = LDO1 配置为旁路 (仅适用于 LDO1_LSW_CONFIG 0x0)
UV 监控	0x1E	4	LDO2_UV_THR	0h = -5% UV 1h = -10% UV

表 4-8. 用于 LDO3 设置的 NVM 寄存器

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
输出电压	0x05	5-0	LDO3_VSET	请参阅数据表上的寄存器映射
配置		6	LDO3_LSW_CONFIG	0h = LDO 模式 1h = LSW 模式
斜坡		7	LDO3_SLOW_PU_RAMP	0h = 上电快速斜坡 1h = 上电慢速斜坡
UV 监控	0x1E	5	LDO3_UV_THR	0h = -5% UV 1h = -10% UV

表 4-9. 用于 LDO4 设置的 NVM 寄存器

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
输出电压	0x04	5-0	LDO4_VSET	请参阅数据表上的寄存器映射
配置		6	LDO4_LSW_CONFIG	0h = LDO 模式 1h = LSW 模式
斜坡		7	LDO4_SLOW_PU_RAMP	0h = 上电快速斜坡 1h = 上电慢速斜坡
UV 监控	0x1E	6	LDO4_UV_THR	0h = -5% UV 1h = -10% UV

4.4 配置 GPIO

GPIO 可用于启用外部分立式元件。GPIO 还可用于多 PMIC 配置，以同步两个 TPS65219 器件之间的上电和断电序列。

- [图 4-5](#) 显示了使用 TPS65219-GUI 时需要更改的设置。
- [表 4-10](#)、[表 4-11](#) 显示了不使用 TPS65219-GUI 时要写入的寄存器字段。

Configuration - NVM fields

READ ALL REGISTERS Note: Changing the value in a dropdown menu will cause an immediate I2C write to the associated register unless immediate write setting is changed on Register Map page.

PMIC Status Power Resources Sequence Digital Pins Configuration

ENABLE

EN / PB / VSENSE (pin# 25)

Pin Configuration: Enable
Deglitch: Short Deglitch
FSD: Disable

Deglitch Reference		
Pin Configuration	Short_deglitch(TYP)	Long_deglitch(TYP)
Enable	120us	50ms
VSENSE	120us	50ms
Push-Button	200ms	600ms

MULTI

VSEL_SD / VSEL_DDR (pin# 12)

Pin Configuration: DDR
Rail Selection: LDO1
VSEL_SD_POLARITY: 0
Note: See Table "VSEL_SD/VSEL_DDR configuration options" in the data sheet for more information about pin polarity
VSEL_SD Control via I2C: 1.8V
Note: VSEL_SD Control has no effect if pin 12 configured as SD

MODE / RESET (pin#28)

Pin Configuration: MODE
Reset Selection: Cold Reset
MODE_RESET_POLARITY: 0
Note: See Table "MODE, STBY and RESET configuration" in the data sheet for more information about pin polarity

MODE / STBY (pin# 31)

Pin Configuration: MODE
MODE_STBY_POLARITY: 0
Note: See Table "MODE, STBY and RESET configuration" in the data sheet for more information about pin polarity
BUCK MODE Control via I2C: Auto PFM

GPIOs

GPIO (pin# 18)

GPIO Config: Single-device config
GPIO Active State: Disabled
GPIO_Standby State: Disabled

GPO1 (pin# 8)

GPO1 Active State: Disabled
GPO1 Standby State: Disabled

GPO2 (pin# 17)

GPO2 Active State: Disabled
GPO2 Standby State: Disabled

图 4-5. GPIO 配置

表 4-10. 用于 GPIO 设置的 NVM 寄存器

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
活动状态下的使能设置	0x1E	2	GPIO_EN	0h = 禁用。输出状态是低电平。 1h = 启用。输出状态为高阻态。
		1	GPO2_EN	0h = 禁用。输出状态是低电平。 1h = 启用。输出状态为高阻态。
		0	GPO1_EN	0h = 禁用。输出状态是低电平。 1h = 启用。输出状态为高阻态。
待机状态下的使能设置	0x22	2	GPIO_STBY_EN	0h = 禁用。输出状态是低电平。 1h = 启用。输出状态为高阻态。
		1	GPO2_STBY_EN	0h = 禁用。输出状态是低电平。 1h = 启用。输出状态为高阻态。
		0	GPO1_STBY_EN	0h = 禁用。输出状态是低电平。 1h = 启用。输出状态为高阻态。

表 4-11. 用于多 PMIC 配置的 NVM 寄存器

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
GPO2 配置	0x1F	3	MULTI_DEVICE_ENABLE	0h = 单器件配置 1h = 多器件配置

4.5 配置序列

配置 PMIC 序列的过程包括以下两个步骤：

1. 上电/下电时隙分配：时隙分配定义了电源轨的开启或关闭顺序。每个 PMIC 电源轨必须分配一个时隙。有 16 个可用时隙 (0-15)。可将多个电源轨 (包括 GPIO) 分配到同一时隙，以便同时启用它们。
2. 上电/下电时隙持续时间：时隙持续时间是指从一个时隙开始到下一时隙开始所隔的时间。例如，如果 Buck1 被分配至持续时间为 3ms 的 slot0，Buck2 被分配至时隙 1，则 Buck2 在 Buck1 后 3ms 开启。

备注

时隙持续时间不能决定电源轨斜升所需的时间。时隙持续时间仅指定 PMIC 在启用 (或禁用) 分配给下一个时隙的电源轨之前等待的时间。

- 图 4-6 显示了使用 TPS65219-GUI 时需要更改的设置
- 表 4-12、表 4-13、表 4-14 和表 4-15 显示了不使用 TPS65219-GUI 时要写入的寄存器字段。

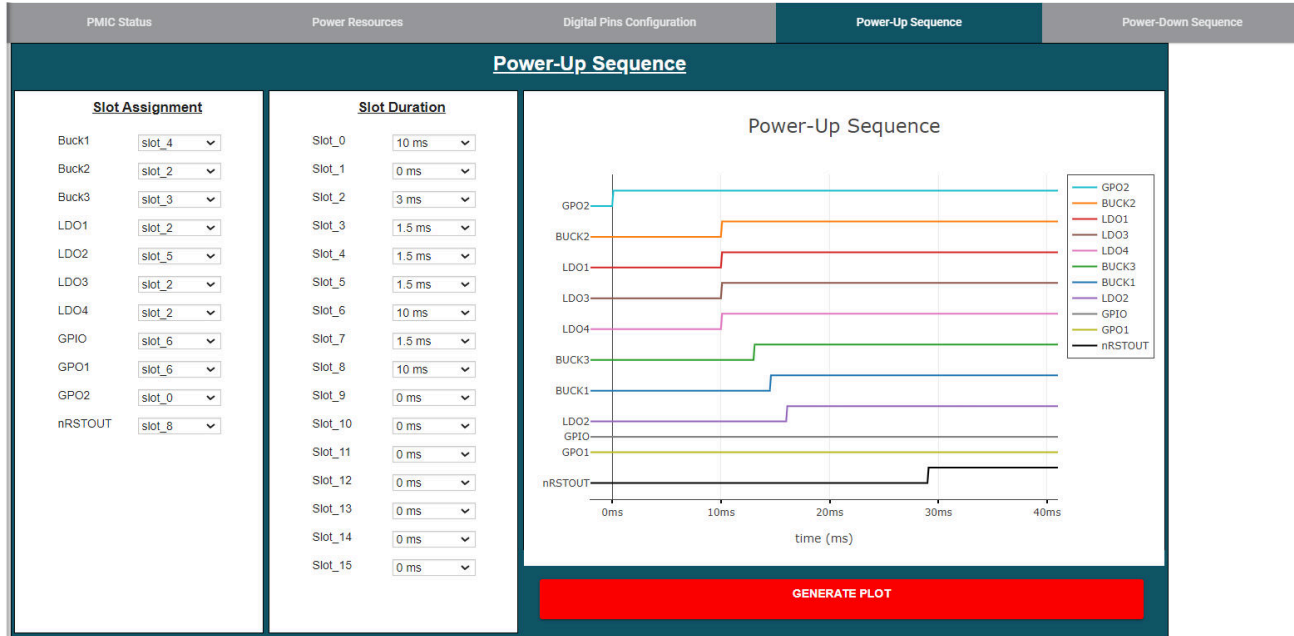


图 4-6. 序列配置

表 4-12. 上电序列 - 时隙分配

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
上电顺序 时隙分配	0x11	7-4	BUCK1_SEQUENCE_ON_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0x10	7-4	BUCK2_SEQUENCE_ON_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0xF	7-4	BUCK3_SEQUENCE_ON_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0xE	7-4	LDO1_SEQUENCE_ON_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0xD	7-4	LDO2_SEQUENCE_ON_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0xC	7-4	LDO3_SEQUENCE_ON_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0xB	7-4	LDO4_SEQUENCE_ON_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0x15	7-4	GPO1_SEQUENCE_ON_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0x14	7-4	GPO2_SEQUENCE_ON_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0x13	7-4	GPIO_SEQUENCE_ON_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0x12	7-4	nRST_SEQUENCE_ON_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射

表 4-13. 上电序列 - 时隙持续时间

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
上电顺序 时隙持续时间	0x16	7-6	POWER_UP_SLOT_0_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		5-4	POWER_UP_SLOT_1_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		3-2	POWER_UP_SLOT_2_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		1-0	POWER_UP_SLOT_3_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
	0x17	7-6	POWER_UP_SLOT_4_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		5-4	POWER_UP_SLOT_5_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		3-2	POWER_UP_SLOT_6_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		1-0	POWER_UP_SLOT_7_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
	0x18	7-6	POWER_UP_SLOT_8_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		5-4	POWER_UP_SLOT_9_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		3-2	POWER_UP_SLOT_10_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		1-0	POWER_UP_SLOT_11_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
	0x19	7-6	POWER_UP_SLOT_12_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		5-4	POWER_UP_SLOT_13_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		3-2	POWER_UP_SLOT_14_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		1-0	POWER_UP_SLOT_15_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射

表 4-14. 下电序列 - 时隙分配

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
断电序列 时隙分配	0x11	7-4	BUCK1_SEQUENCE_OFF_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0x10	7-4	BUCK2_SEQUENCE_OFF_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0xF	7-4	BUCK3_SEQUENCE_OFF_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0xE	7-4	LDO1_SEQUENCE_OFF_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0xD	7-4	LDO2_SEQUENCE_OFF_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0xC	7-4	LDO3_SEQUENCE_OFF_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0xB	7-4	LDO4_SEQUENCE_OFF_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0x15	7-4	GPO1_SEQUENCE_OFF_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0x14	7-4	GPO2_SEQUENCE_OFF_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0x13	7-4	GPIO_SEQUENCE_OFF_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射
	0x12	7-4	nRST_SEQUENCE_OFF_SLOT	请参阅数据表上的寄存器映射

表 4-15. 下电序列 - 时隙持续时间

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
断电序列 时隙持续时间	0x1A	7-6	POWER_DOWN_SLOT_0_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		5-4	POWER_DOWN_SLOT_1_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		3-2	POWER_DOWN_SLOT_2_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		1-0	POWER_DOWN_SLOT_3_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
	0x1B	7-6	POWER_DOWN_SLOT_4_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		5-4	POWER_DOWN_SLOT_5_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		3-2	POWER_DOWN_SLOT_6_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		1-0	POWER_DOWN_SLOT_7_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
	0x1C	7-6	POWER_DOWN_SLOT_8_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		5-4	POWER_DOWN_SLOT_9_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		3-2	POWER_DOWN_SLOT_10_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		1-0	POWER_DOWN_SLOT_11_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
	0x1D	7-6	POWER_DOWN_SLOT_12_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		5-4	POWER_DOWN_SLOT_13_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		3-2	POWER_DOWN_SLOT_14_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射
		1-0	POWER_DOWN_SLOT_15_DURATION	请参阅数据表上的寄存器映射

4.6 配置多功能引脚

TPS65219 PMIC 有三个可配置多功能引脚。MODE/STBY 和 MODE/RESET 可配置为 MODE (以选择开关)、STBY (以触发至待机状态的转换)，或配置为 RESET (以触发冷复位或热复位)。可将 VSEL_SD/VSEL_DDR 引脚配置为设置 LDO1 或 LDO2 (可选) 上的输出电压或设置 Buck3 上的输出电压。有关引脚极性信息，请参阅数据表。

备注

如果 VSEL_SD/VSEL_DDR 未用于设置 LDO1 (或 LDO2) 上的输出电压，则必须将其配置为 DDR，并使用原理图中的下拉电阻将其拉至 GND。此外，VSEL_SD_I2C_CTRL 必须编程为 1h。

- 图 4-7 显示了使用 TPS65219-GUI 时需要更改的设置
- 图 4-7 显示了不使用 TPS65219-GUI 时要写入的寄存器字段。

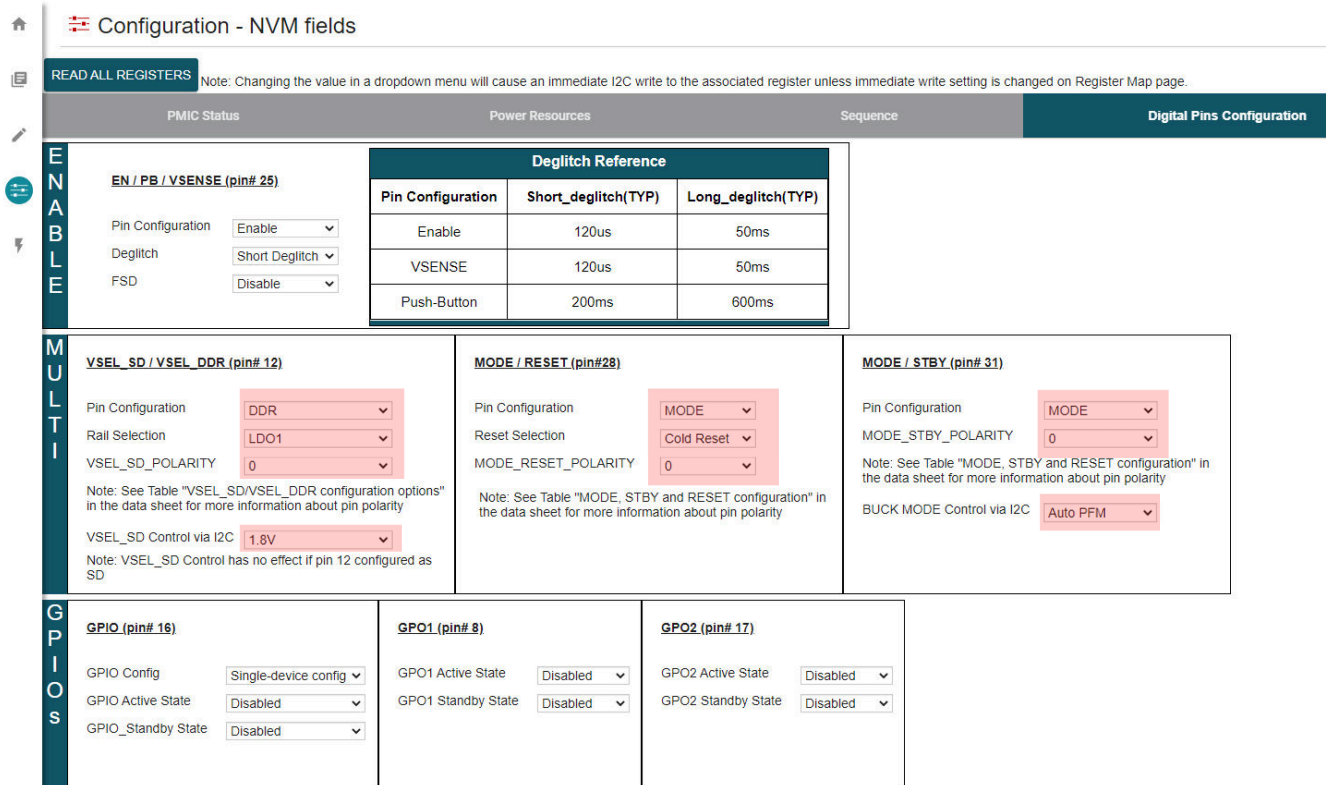


图 4-7. 使用 TPS65219-GUI 的多功能配置

表 4-16. 用于 VSEL_SD/VSEL_DDR 的 NVM 寄存器

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
引脚功能	0x1F	0	VSEL_DDR_SD	0h = VSEL 引脚配置为 DDR，以设置 Buck3 上的电压 1h = VSEL 引脚配置为 SD，以设置 VSEL_RAIL 上的电压
VSEL 电源轨选择		2	VSEL_RAIL	0h = LDO1 1h = LDO2
引脚极性		1	VSEL_SD_POLARITY	0h = • 低电平：1.8V • 高电平：LDOx_VOUT 寄存器 1h = • 高电平：1.8V • 低电平：LDOx_VOUT 寄存器

表 4-17. 用于 MODE/STBY 的 NVM 寄存器

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
引脚功能	0x20	1-0	MODE_STBY_CONFIG	0h = MODE 1h = STBY 2h = MODE 和 STBY 3h = MODE
引脚极性	0x1F	4	MODE_STBY_POLARITY	请参阅数据表上的寄存器映射

表 4-18. 用于 **MODE/RESET** 的 **NVM** 寄存器

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
引脚功能	0x20	2	MODE_RESET_CONFIG	0h = MODE 1h = RESET
RESET 配置		6	WARM_COLD_RESET_CONFIG	0h = COLD RESET 1h = WARM RESET
引脚极性	0x1F	5	MODE_RESET_POLARITY	请参阅数据表上的寄存器映射

4.7 配置 EN/PB/VSENSE 引脚

PMIC 的使能引脚可配置为“Enable”、“Push-Button”或“VSENSE”。除此功能外，还可以配置抗尖峰脉冲。此外，该引脚还具有首次电源检测 (FSD) 选项，从而在首次上电期间忽略 EN/PB/VSENSE 引脚的状态。

- 图 4-8 显示了使用 TPS65219-GUI 时需要更改的设置。
- 表 4-19 显示了不使用 TPS65219-GUI 时要写入的寄存器字段。

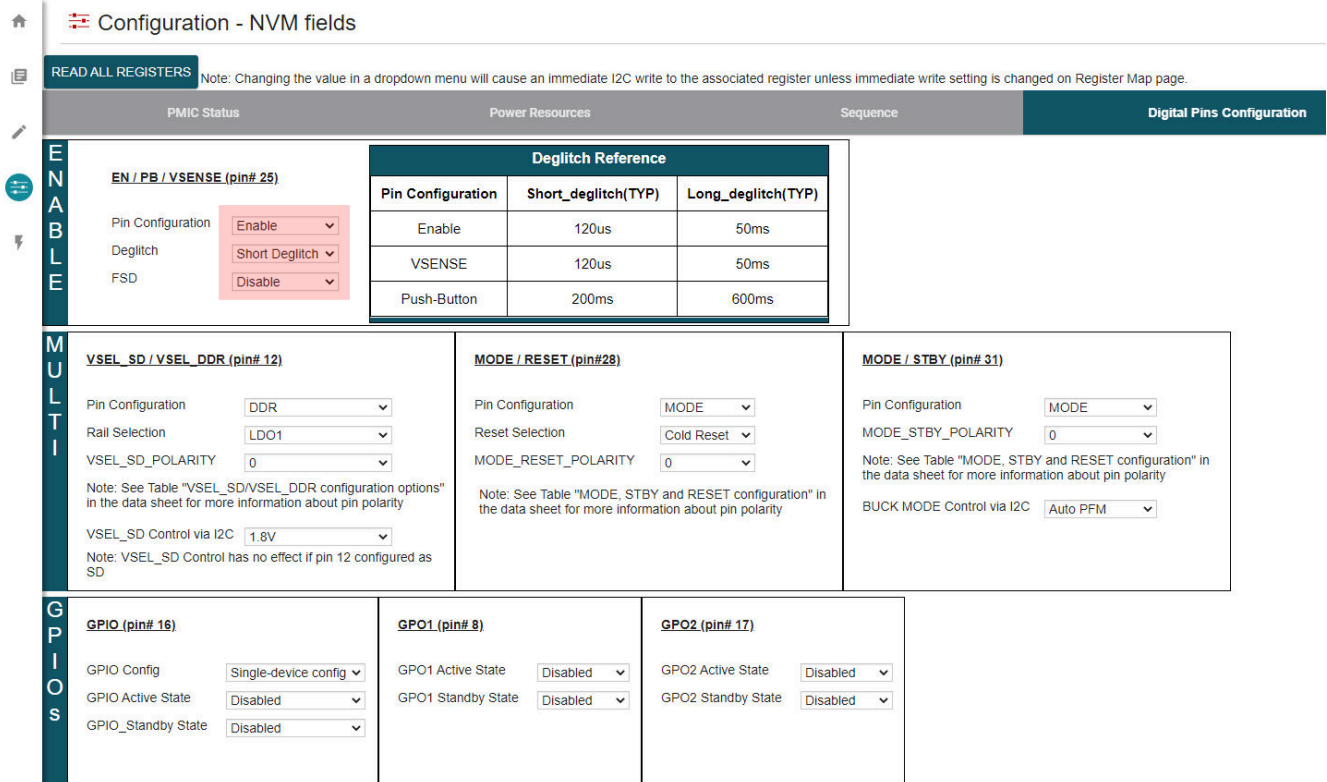


图 4-8. 使用 TPS65219-GUI 的 EN/PB/VSENSE 配置

表 4-19. 用于 EN/PB/VSENSE 的 NVM 寄存器

	寄存器地址	位		设置
		位编号	字段名称	
首次电源检测	0x20	7	PU_ON_FSD	0h = FSD 已禁用 1h = FSD 已启用
引脚配置		5-4	EN_PB_VSENSE_CONFIG	0h = 启用 1h = 按钮 2h = VSENSE 3h = 使能
抗尖峰脉冲		3	EN_PB_VSENSE_DEGL	请参阅数据表上的寄存器映射

4.8 更改 I2C 地址

TPS6521905 的默认 I2C 地址配置为 0x30。如果需要，可以通过在 TPS65219_GUI 的寄存器映射中搜索寄存器 I2C_ADDRESS_REG 并更改默认的 0x30 地址来更改此配置，如图 4-9 所示。一旦更改了寄存器，必须通过将 0x0A 写入寄存器 0x34 来将新值保存到 NVM 中。

备注

在多 PMIC 配置中使用多个 TPS65219 器件时，每个器件必须具有唯一的 I2C 地址。第 2 个、第 3 个和其他 PMIC 的 I2C 地址必须从默认值 0x30 更改为新值。

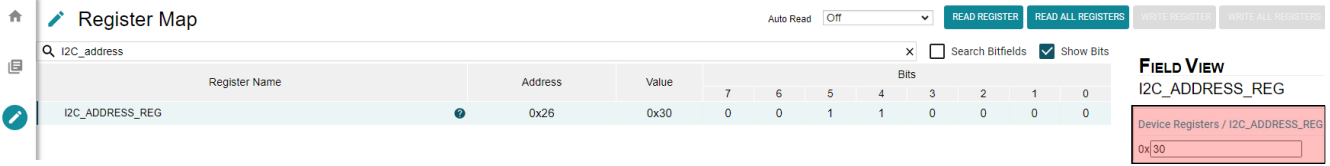


图 4-9. I2C_ADDRESS_REG

表 4-20. I2C_ADDRESS_REG

寄存器地址	位	
	位编号	字段名称
0x26	6-0	I2C_ADDRESS_REG

4.9 配置屏蔽设置

有多种中断设置可被屏蔽，从而绕过特定 PMIC 监控功能或修改 PMIC 在检测到中断时的反应方式。可以屏蔽的中断包括欠压监测、温度监测等。图 4-10 显示了 GUI 配置选项卡中的屏蔽设置。

备注

如果任何屏蔽寄存器未显示在 TPS65219-GUI 的配置选项卡中，则可以在包含完整寄存器列表的寄存器映射中找到它们。

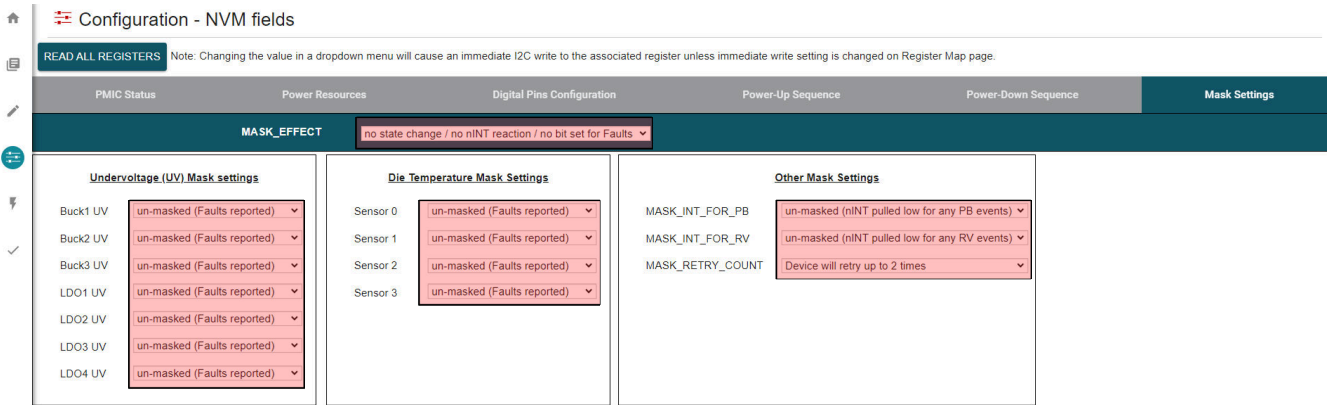


图 4-10. TPS65219-GUI 中的屏蔽设置

表 4-21. 寄存器 0x1E 上的屏蔽设置

寄存器地址	位	
	位编号	字段名称
0x1E	7	BYPASS_RAILS_DISCHARGED_CHECK

表 4-22. 寄存器 0x1E 上的屏蔽设置

寄存器地址	位	
	位编号	字段名称
0x24	7	MASK_RETRY_COUNT
	6	BUCK3_UV_MASK
	5	BUCK2_UV_MASK
	4	BUCK1_UV_MASK
	3	LDO4_UV_MASK
	2	LDO3_UV_MASK
	1	LDO2_UV_MASK
	0	LDO1_UV_MASK

表 4-23. 寄存器 0x1E 上的屏蔽设置

寄存器地址	位	
	位编号	字段名称
0x25	7	MASK_INT_FOR_PB
	6-5	MASK_EFFECT
	4	MASK_INT_FOR_RV
	3	SENSOR_0_WARM_MASK
	2	SENSOR_1_WARM_MASK
	1	SENSOR_2_WARM_MASK
	0	SENSOR_3_WARM_MASK

4.10 NVM 重新编程

更新寄存器设置后，可以通过将 0x0A 写入寄存器地址 0x34 而将新值保存到 NVM 中。

- 图 4-11 显示了使用 TPS65219-GUI 时用于将寄存器设置保存到 NVM 的按钮。
- 表 4-24 显示了不使用 TPS65219-GUI 时要写入的寄存器字段。

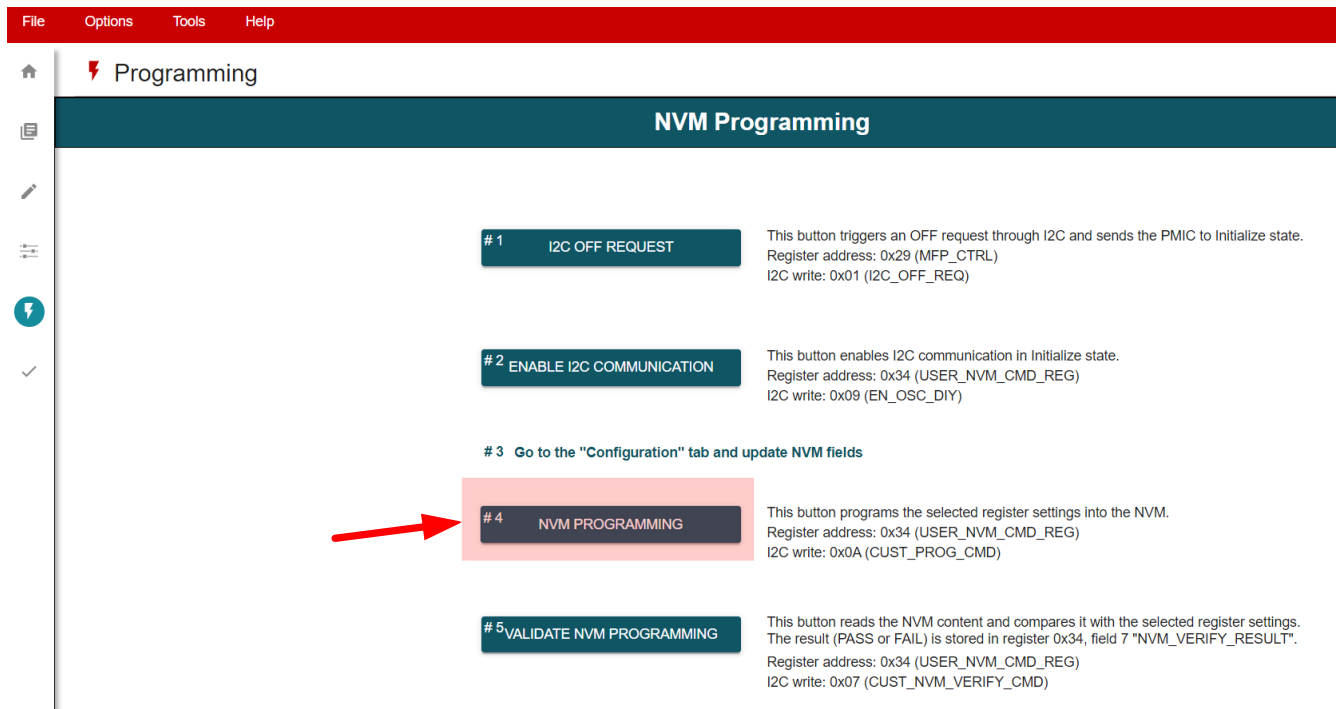


图 4-11. 使用 TPS65219-GUI 重新对 NVM 进行编程

表 4-24. 用以将寄存器设置保存到 NVM 中的 I2C 写入

寄存器地址	位		数据
	位编号	字段名称	
0x34	3-0	USER_NVM_CMD	0x0A

备注

建议使用 TPS65219-GUI 将所选的寄存器设置导出到 CSV 和 JSON 文件中。图 4-12 展示了如何导出 NVM 设置。使用“Save Registers As”之前，必须在“Register File Format”中选择文件格式。

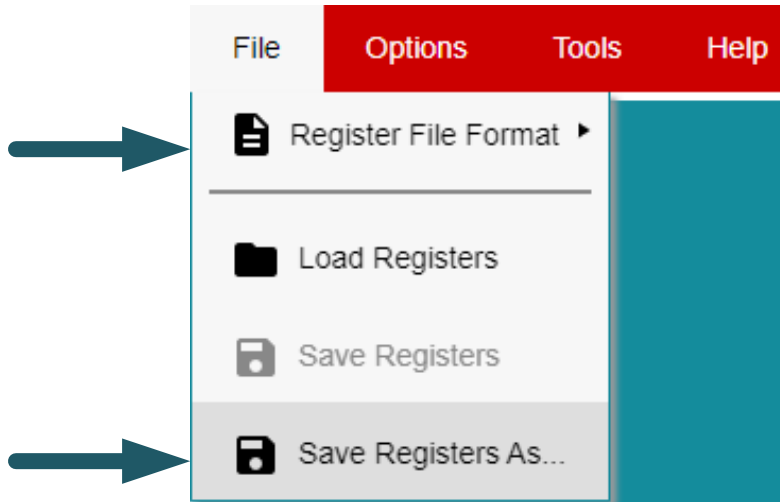


图 4-12. 使用 TPS65219-GUI 导出 NVM 设置

A 非 NVM 寄存器

PMIC 寄存器映射包含 NVM 和非 NVM 位。寄存器地址 0x00 至 0x27 包含由 EEPROM 备份的 NVM 位。该寄存器设置可通过 I2C 进行更改，并且可按照编程指南中所述对默认值重新编程。每个 NVM 位的复位值在数据表寄存器映射中标记为“X”，因为这些值可以重新进行编程，并且对于每个可订购器件型号都是唯一的。

非 NVM 位位于寄存器地址 0x28 至 0x41 中。这些寄存器设置可由 I2C 更改，但默认值无法重新进行编程。下电上电后以及每次 PMIC 进入初始化状态时，非 NVM 位的寄存器设置都会恢复为其默认值。可以在数据表寄存器映射中的“复位”列下找到非 NVM 位的默认值。

B 将 NVM 配置文件加载到 PMIC

图 B-1 中所示的图描述了将预配置的 NVM 文件 (.CSV 或 .JSON 扩展名) 加载到 PMIC NVM 中的过程。焊接 EVM (TPS65219EVM) 可用作参考,但也可使用插槽式 EVM。TPS6521905 产品页面包含多个 NVM 文件,这些文件经过预先配置,可满足特定处理器或 SoC 的要求。TI 的客户可以重复使用这些文件,在其生产线上或通过与经销商联系来对 PMIC 重新编程。

备注

如果预先配置的 NVM 文件无法满足所有应用要求,则仍可使用 TPS65219-GUI 将这些文件加载到 PMIC NVM、进行必要的更改并生成新的 NVM 文件。

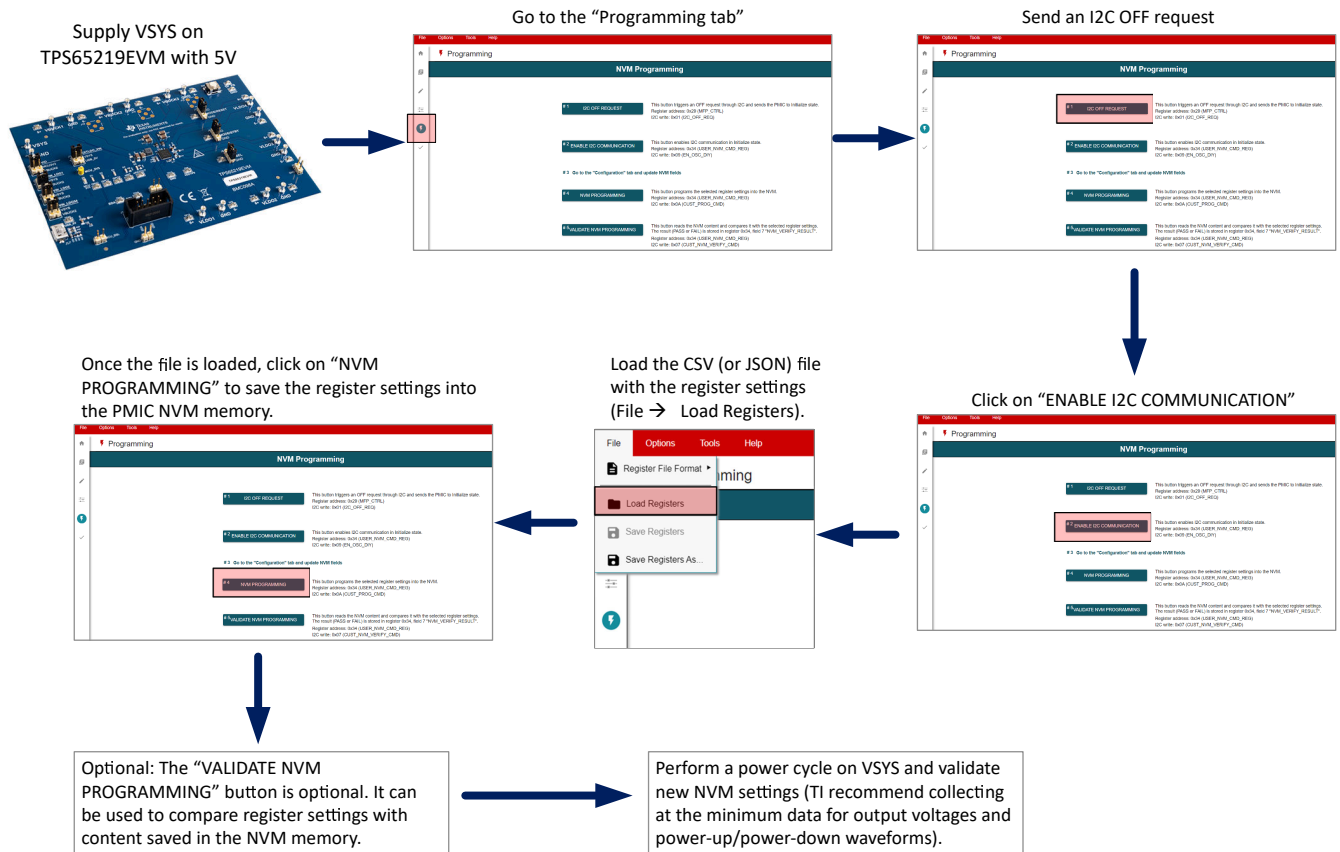


图 B-1. 加载 NVM 配置文件

C PMIC 可配置字段

本节展示了每个 PMIC 电源和数字资源的可编程 NVM 字段列表。一些寄存器字段带有“x”以简化列表。将“x”替换为相应的电源轨编号，即可在数据表或编程指南中找到正确的寄存器字段。同样，对于序列时隙持续时间，使用“y”来简化列表，但可将其替换为特定的时隙编号。

PMIC rail	Configurable Setting	Register Field
Bucks	Enable settings	Active State: Buck x _EN Standby State: BUCK x _STBY_EN
	Output voltage	BUCK x _VSET
	Under-voltage monitoring	BUCK x _UV_THR_SEL
	Bandwidth	BUCK x _BW_SEL
	Power-up sequence	Slot#: BUCK x _SEQUENCE_ON_SLOT Duration: POWER_UP_SLOT_ y _DURATION
	Power-down sequence	Slot#: BUCK x _SEQUENCE_OFF_SLOT Duration: POWER_DOWN_SLOT_ y _DURATION
LDOs	Enable settings	Active State: LDO x _EN Standby State: LDO x _STBY_EN
	Output voltage	LDO x _VSET
	Under-voltage monitoring	LDO x _UV_THR_SEL
	Rail config (LDO, load-switch, bypass)	LDO x _LSW_CONFIG LDO x _BYP_CONFIG (LDO1, LDO2 only)
	Ramp	LDO x _SLOW_PU_RAMP (LDO3, LDO4 only)
	Power-up sequence	Slot#: LDO x _SEQUENCE_ON_SLOT Duration: POWER_UP_SLOT_ y _DURATION
	Power-down sequence	Slot#: LDO x _SEQUENCE_OFF_SLOT Duration: POWER_DOWN_SLOT_ y _DURATION
GPIOs	Enable settings GPIO	Active State: GPI/O x _EN Standby State: GPI/O x _STBY_EN
	Pin Function	MULTI_DEVICE_ENABLE (GPIO only)
	Power-up sequence	Slot#: GPI/O x _SEQUENCE_ON_SLOT Duration: POWER_UP_SLOT_ y _DURATION
	Power-down sequence	Slot#: GPI/O x _SEQUENCE_OFF_SLOT Duration: POWER_DOWN_SLOT_ y _DURATION
Enable pin	Pin Function	EN_PB_VSENSE_DEGL
	Deglintch	EN_PB_VSENSE_CONFIG
	First Supply Detection (FSD)	PU_ON_FSD
VSEL_SD VSEL_DDR	Pin Function	VSEL_DDR_SD
	Rail Selection	VSEL_RAIL
	Pin Polarity	VSEL_SD_POLARITY
MODE/STBY	Pin Function	MODE_STBY_CONFIG
	Pin Polarity	MODE_STBY_POLARITY
MODE/RESET	Pin Function	MODE_RESET_CONFIG
	RESET selection	WARM_COLD_RESET_CONFIG
	Pin Polarity	MODE_RESET_POLARITY
nRSTOUT	Power-up sequence	Slot#: nRST_SEQUENCE_ON_SLOT Duration: POWER_UP_SLOT_ y _DURATION
	Power-down sequence	Slot#: nRST_SEQUENCE_OFF_SLOT Duration: POWER_DOWN_SLOT_ y _DURATION

图 C-1. NVM 可编程字段

D 参考文献

1. 德州仪器 (TI), [TPS6521905 数据表](#)
2. 德州仪器 (TI), [TPS65219EVM-SKT 用户指南](#)

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2023，德州仪器 (TI) 公司